

19 ИЮНЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

- 9:45** **Открытие конференции.**
Коломийцевская лекция. K.D. Tsendin
A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, Russian Academy of Science
Peculiarities of information recording on chalcogenide glassy semiconductors.
- 10:40** **А.Н.Лачинов**
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН
Электронные свойства органических полупроводников на основе несопряженных полимеров
- 11:10** **Czang-Ho Lee, Andrei Sazonov, and Arokia Nathan**
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada
Nanocrystalline silicon thin-film transistors for flexible electronics

11:40-12:00 кофе

- 12:00** **А.Б. Певцов, А.А. Андреев, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, Б.Т. Мелех, В.Г. Голубев**
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург
Фотонные кристаллы на основе халькогенидов германия: получение, структурные, электрические и оптические свойства
- 12:30** **А.Косарев, А.Torres**
National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics, Puebla, Mexico
Un-cooled micro-bolometers based on plasma deposited films
- 13:00** **В.А. Быков**
ЗАО Группа «НТ-МДТ», г. Зеленоград
Новые возможности зондовой микроскопии
- 13:30** **А.П. Авачев¹, В.А. Быков², Н.В. Вишняков¹, С.П. Вихров¹, В.Г. Мишустин¹, И.Г. Уточкин¹**
¹*Рязанская государственная радиотехническая академия*
²*ЗАО "Нанотехнология - МДТ", г. Зеленоград*
Применение атомно – силовой микроскопии для исследования электрофизических свойств микро- и наноразмерных объектов на неупорядоченных полупроводниках

14:00-15:00 обед

СЕКЦИЯ А

АМОРФНЫЙ ГИДРИРОВАННЫЙ КРЕМНИЙ И СПЛАВЫ НА ЕГО ОСНОВЕ

- 15:00** А.А. Шерченков, А.Б. Апальков
Московский государственный институт электронной техники.
Распределение зарядовых состояний в щели подвижности α -Si:H.
- 15:20** М.С. Бреслер¹, О.Б. Гусев¹, Е.И. Теруков¹, Ю.К. Ундалов¹, А.В. Мудрый²,
Б.А. Андреев³, З.Ф. Красильник³, А.Н. Яблонский³
¹ *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия*
² *Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ, Минск, Беларусь*
³ *Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия*
Фотолюминесценция эрбия в гетерогенной матрице аморфного кремния, полученного магнетронным распылением
- 15:40** А.Г. Казанский, К.Ю. Хабарова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Москва,
Фотоиндуцированное изменение проводимости в легированном и компенсированном аморфном гидрированном кремнии
- 16:00** Б.М. Синельников, В.А. Тарала, Л.А. Кашарина, И.С. Митченко
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь
Температурная зависимость электропроводности пленок α -SiC:H

16:20-16:40 кофе

СЕКЦИЯ В

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

- 16:40** К. А. Осипов, В. Н. Павловский, Е. В. Луценко, А. Л. Гурский,
Г. П. Яблонский, S. Hartmann², A. Janssen², R. Caspary, Н.-Н. Johannes²,
W. Kowalsky², N. Meyer³, M. Gersdorff³, P. van Gemmern⁴, C. Zimmermann⁴,
F. Jessen⁴, H. Kalisch⁴, R. H. Jansen⁴, M. Heuken^{3,4}
¹ *Институт физики Национальной академии наук Беларуси, просп. Независимости 68, 220072 Минск, Беларусь*
² *Institut für Hochfrequenztechnik, Technische Universität Braunschweig, Schleinitzstraße 22, 38106 Braunschweig, Germany*
³ *AIXTRON AG, D-52072 Aachen, Germany*
⁴ *Institut für Theoretische Elektrotechnik, RWTH Aachen, Kopernikusstraße 16, 52074 Aachen, Germany*
Влияние интенсивности и продолжительности лазерного облучения на фотолюминесценцию тонких органических пленок α -NPD

- 17:00 * **Р.Б. Салихов**, ** **А.Н. Лачинов**, * **Р.Г. Рахмеев**, * **А.А. Бунаков**
* *Башкирский государственный педагогический университет*
** *Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН*
О механизмах проводимости в гетероструктурах кремний - полимер- металл
- 17:20 **Э.А. Лебедев**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук.
Санкт-Петербург, Политехническая 26, 194021, Россия
Инжекция и дрейф носителей заряда в слоях полифенилвинилена (PPV)
- 17:40 **Ю.М. Юмагузин¹**, **В.М. Корнилов²**, **А.Н. Лачинов²**
¹ *Башкирский государственный университет, г. Уфа*
² *Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, г. Уфа*
Исследование электронных свойств структуры металл-полимер методом полевой эмиссионной спектроскопии

18:00 WELCOME PARTY

20 ИЮНЯ

СЕКЦИЯ С

АМОРФНЫЙ УГЛЕРОД И ДРУГИЕ ШИРОКОЗОННЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКИ

- 9:00 **Б.А. Наджафов**
Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку
Электрические свойства пленок $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}_z$ и изменение их параметров в зависимости от концентрации углерода
- 9:20 **Е.П. Светлов-Прокопьев***, **С.П. Тимошенко****, **О.М. Бритков****, **В.И. Графутин***, **С.А. Зотов****, **В.В. Калугин****, **Ю.Я. Лапицкий***, **Ал.С. Тимошенко****
* *Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова, Москва*
** *Московский институт электронной техники (технический университет)*
Изучение режимов процесса роста слоев алмаза в газовой смеси $\text{CH}_4 + \text{H}_2$ пониженного давления в методе нагретой нити
- 9:40 **М.Д. Ефремов¹**, **В.А. Володин¹**, **С.А. Аржанникова¹**, **Г.Н. Камаев¹**, **С.А. Кочубей¹**, **Д.В. Марин¹**, **А.А. Попов²**, **Ю.А. Минаков²**
¹ *ИФП СО РАН, пр. ак. Лаврентьева 13, Новосибирск*
² *ИМИ РАН, ул. Университетская 21, Ярославль*
Вариация оптических свойств пленок SiN_x с кремниевыми кластерами, модифицированных посредством лазерного воздействия.
- 10:00 **В.М. Лебедев**, **А.А. Васильев**, **М.Е. Взнуздаев**, **П.А. Кравцов**, **Л.М. Коченда**,

М.С. Микиртычьянц, В.А. Трофимов

*Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН,
Гатчина*

Изготовление, определение состава и толщины самоподдерживающихся тонких углеродных пленок

10:20 В.В. Соболев и В.Вал. Соболев

Удмуртский государственный университет, Ижевск

Спектры пропускания характеристических потерь электронов и оптические свойства одиночных и многослойных углеродных нанотрубок

10:40 С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

О соотношении sp^2/sp^3 для аморфного углерода и родственных нанокompозитов

11:00 Р.Н. Грищевич^{*}, Э.И. Точицкий^{*}, Н.А. Поклонский^{}, М. Самбуу^{**},
Н.И. Горбачук^{**}, Н.М. Лапчук^{**}**

^{} Научный инженерный центр «Плазмотег» Физико-технического
института НАН Беларуси, Минск*

*^{**} Белорусский государственный университет, Минск*

Диагностика методом ЭПР пленок алмазоподобного углерода

11:20-11:40 кофе

СЕКЦИЯ D

ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ И СТЕКЛООБРАЗНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

**11:40 Ш.Ш Сарсембинов¹, О.Ю. Приходько¹, А.П. Рягузов¹, С.Я. Максимова¹,
Р.М. Искаков², В.Ж. Ушанов¹**

¹Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

²Институт химических наук, Алматы, Казахстан

Особенности атомной структуры аморфных пленок As_2S_3 , полученных разными методами

12:00 Д.А. Kurdyukov, S.F. Kaplan, N.F. Kartenko, A.V. Medvedev, and V.G. Golubev

Ioffe Physico-Technical Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg

Photo- and electroluminescence of new opal- sulfide and opal-silicate phosphor composites

12:20 В.Ю. Колосов, Л.М. Веретенников

УрГЭУ, г. Екатеринбург

Применение электронов для локальных переключений аморфная фаза-кристалл и исследования особенностей структуры в халькогенидных плёнках

12:40 А.М. Andries, M.S. Iovu, S.A. Buzurniuc, V.I. Verlan, E.P. Colomeico

Center of Optoelectronics of the Institute of Applied Physics,

Academy of Sciences of Moldova
New composites materials based on chalcogenide glasses and polymer

13:00 **A.V. Kolobov**
CANFOR-AIST, Tsukuba Central 4, 1-1-1 Higashi, Ibaraki 305-8562 Japan and LPMC, UMR CNRS 5617, Universit s Montpellier II, Montpellier 34095, France
Chalcogenide glasses for advanced memory applications

13:20 **M.S. Iovu, A.M. Andries, N.N. Syrbu, E.V. Lupan, V.I. Ciornea, E.P.Colomeico, Yu.S. Tver'yanovich^a, G.J.Adriaenssens^b**
Center of Optoelectronics, IAP, ASM, Str. Academiei 1, MD-2028 Chisinau, R. Moldova
^a*Russian Center of Laser Physics, St. Petersburg State University, St. Petersburg,*
^b*Laboratorium voor Halfgeleiderfysica, K.U. Leuven, B-3001 Heverlee-Leuven, Belgium*
Photoluminescence of Ga_{0.017}Ge_{0.25}As_{0.083}S_{0.65} glasses doped with rare earth ions

13:20-14:20 **обед**

14:20 **Э.Н. Воронков, С.А. Козюхин*, Е. И.Микерина**
Московский энергетический институт, Москва
**Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва*
Электрические характеристики аморфных пленок As₂Se₃, содержащих кислород

14:40 **Н.В. Болягин, С.П. Вихров, Т.Г. Ларина, С.М. Мурсалов**
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань
Методика исследования самоорганизации неупорядоченных материалов с применением теории информации

15:00 **А.Г.Никитина, В.В.Зуев**
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
Особенности влияния бистабильных амфотерных центров с отрицательной корреляционной энергией на температурную зависимость концентрации свободных носителей в полупроводнике.

15:20 **В.С. Минаев¹, И.М. Терашкевич¹, С.П. Тимошенко², С.Н. Новиков², В.В. Калугин², Е.Н. Маркова²**
¹*ЗАО «НИИ Материаловедения», Москва*
²*Московский институт электронной техники (Технический университет)*
Наногетероморфная структура и релаксационные процессы в некристаллических полупроводниках и диэлектриках (халькогенидах, оксидах, галогенидах, углероде и кремнии)

15:40 **С.А. Козюхин⁽¹⁾, Н.Д. Васильева⁽²⁾, Е.А. Бабенко⁽²⁾**
⁽¹⁾*Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва*
⁽²⁾*Московский энергетический институт (ГУ)*
Влияние комплексных соединений РЗЭ Ln(Thd)₃ (Ln=Eu, Tb, Er, Yb) на

морфологию поверхности аморфных пленок триселенида мышьяка

16:00-17:00 кофе

16:00 СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ А

**АМОРФНЫЙ ГИДРИРОВАННЫЙ КРЕМНИЙ И
СПЛАВЫ НА ЕГО ОСНОВЕ**

- A01.** **А.И. Машин, А.В. Нежданов, В.Г. Шенгуров, А.Г. Разуваев**
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Свойства структурно неоднородного аморфного кремния, легированного эрбием
- A02.** **А.В. Васин, С.П. Колесник, А.А. Кончиц, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, А.В. Русавский, Yukari Ishikawa***
Институт физики полупроводников НАН Украины, Киев, Украина
**Japanese Fine Ceramic Center, Nagoya, Japan*
Влияние низкотемпературного отжига на люминесцентные свойства обогащенных углеродом пленок α -SiC:H
- A03.** **А.М. Сатанин* , Д.И. Тетельбаум, Ю.А. Менделева, В.А. Бурдов**
**Институт физики микроструктур РАН*
Научно-исследовательский Физико-технический институт ННГУ
Квантовая локализация в кремниевых кристаллитах, находящихся в α -Si матрице
- A04.** **А.Г. Казанский, А.А. Хомич**
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Электрические и фотоэлектрические свойства тонких пленок аморфного гидрированного кремния
- A05.** **Е.И Теруков*, Т.Б. Данегулова, Б.М. Кабланбеков, Е.А. Сванбаев, Т.И. Таурбаев**
**ФТИ им. А.Ф. Иоффе,*
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы.
Металл- индуцированные изменения оптических параметров аморфного кремния при отжиге
- A06.** **С.М. Манаков, Б.М. Кабланбеков, Т.И. Таурбаев**
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы,
Влияние температуры осаждения на фоточувствительность пленок аморфного гидрогенизированного кремния
- A07.** **Авачев А.П.¹, Вишняков Н.В.¹, А.А. Попов², Уточкин И.Г.¹, Юлкин А.В.¹**
¹Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань

²Институт микроэлектроники и информатики РАН, г. Ярославль, Россия
Зависимость оптической ширины запрещенной зоны и структуры пленок a-Si:H

- A08.** **А.П. Авачёв¹, С.П. Вихров¹, А.А. Попов², И.Г. Уточкин¹, А.В. Юлкин¹**
¹Рязанский Государственный радиотехнический университет, Рязань
²Институт микроэлектроники и информатики РАН, г. Ярославль
Взаимосвязь микроструктуры и спектров оптического поглощения плёнок a-Si:H, полученных методом НЧ ПХО
- A09.** **В.П.Афанасьев¹, О.И.Коньков², Н.А.Селюженок¹, Е.И.Теруков²,**
¹Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»
²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Исследование слоистых пленок a-Si:H, полученных методом циклического осаждения и отжига в плазме квазизамкнутых объемов
- A10.** **В.П.Афанасьев¹, О.И.Коньков², Н.А.Селюженок¹, Е.И.Теруков²,**
¹Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»
²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Метод получения наноструктурированных слоистых пленок a-Si:H для оптоэлектронных применений
- A11.** **И. А. Курова, Н. Н. Ормонт**
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Влияние температуры и интенсивности освещения на образование метастабильных состояний в a-Si:H.
- A12.** **А. А. Шерченков, Б.Г. Будагян, Е.Д. Мнацаканян, Е.В. Горшкова**
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Дифференциальная сканирующая калориметрия тонких пленок a-Si:H
- A13.** **Н.И. Файнер, Ю.М. Румянцев, Е.А. Максимовский, В.В. Кириенко, В.Г. Кеслер, Б.М. Аюпов, А.Н. Голубенко, Ф.А. Кузнецов**
ИНХ СО РАН, Новосибирск
Перспективные LOW-K диэлектрики на основе аморфных пленок тройных соединений SiC_xN_y переменного состава
- A14.** **А.Б. Шмелькин, К.Д. Цэндин**
СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия.
Влияние заряда центров на электролюминесценцию эрбия в светодиодах на основе неупорядоченных полупроводников.
- A15.** **N.H.Nickel, M.Weizman, Е.Е.Терукова***
Hahn-Meitner Institut, Berlin
*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Оптические свойства тонких поликристаллических пленок Si_xGe_{1-x}, полученных методом лазерной кристаллизации
- A16.** **А.М.Полянский, В.А. Полянский, Е.И. Теруков*, О.И. Коньков***

ООО «НПК электронные и пучковые технологии»,
*ФТИРАН им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Получение слоев аморфного кремния, кремния, легированного 1% В и аморфного углерода на поверхности монокристаллического кремния; определение количества и энергии связи водорода в аморфных слоях

- A17. **А. П. Авачёв, Н.В. Вишняков, С.П. Вихров, К.В. Митрофанов, И.Г. Уточкин**
Рязанский государственный радиотехнический университет
Измерение потенциала и плотности локализованных состояний в пленках неупорядоченных полупроводников

СЕКЦИЯ В

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

- В01. А.С.Комолов**
Научно-исследовательский институт физики им. В. А. Фока Санкт-Петербургского государственного университета, Петродворец, Санкт-Петербург
Полупроводниковые пленки олиго(фенилен-винилена) на поверхности твердого тела
- В02. А.А. Лачинов, Н.В. Воробьева***
Башкирский Государственный Университет
**Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН*
Инжекционное магнетосопротивление в системе полимер-ферромагнетик
- В03. Э.К. Алиджанов, Ю.Д. Лантух, С.Н. Легута, С.Н. Пашкевич, Т.М Чмерева**
Оренбург, Пр. Победы, 13, Оренбургский государственный университет.
Экситоны в наноструктурах, сформированных из органического полупроводника - N,N'-DBPTCDI
- В04. Р. М. Искаков¹, Е. Л. Вечеркина¹, Б. А. Жубанов¹, Е. С. Стефанова², О. Ю. Приходько²**
¹Институт химических наук, ул. Уалиханова, 106
²Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казах стан
Корреляция структуры металлизированных полиимидных пленок и их электропроводящих свойств
- В05. А.Г. Казанский, А.В. Фенухин**
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Электрические и фотоэлектрические свойства тонких пленок перилена
- В06. Д.А. Костерин, Г.Л. Пахомов, А.В. Мурель, В.И. Шашкин**
Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
Проводимость структур p-Si/фталоцианин/металл

- В07.** А.В. Зиминов, А.А. Алексеева, С.М. Рамш, Т.А. Юрре
*Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет), Санкт-Петербург, 198013, Московский пр., д.26*
N – гетероциклические производные фталоцианина меди: синтез и
спектральные исследования
- В08.** А.В. Зиминов, А.А. Алексеева, С.М. Рамш, Т.А. Юрре
*Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(Технический университет), Санкт-Петербург*
Интегральная светочувствительность металлофталоцианинов в полимерной
матрице
- В09.** В.Х. Ильясов *, А.Н. Лачинов *, А.В. Мошелёв *, А.Ф. Пономарев **
* *Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, г. Уфа*
** *Бирская государственная социально-педагогическая академия, г. Бирск*
Влияние электрического поля на термостимулированное электронное
переключение в полимерном полупроводнике
- В10.** Т. Р. Ганиев, А. Н. Лачинов, А. Ю. Жеребов
Башкирский Государственный Университет
* *Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН*
Изучение эффекта электронного переключения в тонких полимерных пленках
индуцированного малым одноосным давлением
- В11.** Р.Б. Салихов *, А.Н. Лачинов **
* *Башкирский государственный педагогический университет*
** *Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН*
Исследование свойств тонких полимерных пленок полидифениленфталида
- В12.** Ю.Г. Аляев, С.А. Комолов, И.С. Бузин
Научно-исследовательский институт физики им. В.А. Фока Санкт-Петербургского государственного университета, г. С.-Петербург
Фотовольтаические явления на интерфейсах РТСДА/InAs и РТСДА/GaAs
- В13.** Г.И. Носова, Е.Л. Александрова, Н.А. Соловская, К.А. Ромашкова,
А.В. Якиманский, В.В. Кудрявцев.
Институт высокомолекулярных соединений РАН.
Фотопроводимость полиимидов и полихиназолонов, содержащих фрагменты
трифениламина
- В14.** Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман*, И.В. Подешво*, В.В. Кудрявцев*
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
* *Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук,*
Санкт-Петербург
Гистерезис температурной зависимости проводимости в слоях металл-
полимерного комплекса полиамидокислоты с Tb и полифениленвинилена
(PPV)
- В15.** Е.Ю. Меленевская¹, Д.Н. Орлова³, А.Г. Иванов¹, Е.И. Теруков², В.В. Шаманин¹

¹Институт высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург

³Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина

Проводящие композиционные материалы на основе наноуглеродных волокон и растворимого полипиррола

- В16. И.В.Чалов, Н.М.Геллер, Л.Б.Надеждина, В.В.Шаманин**
Институт Высокомолекулярных Соединений РАН, Санкт-Петербург
Электропроводящие поли(салицилиденазометины), содержащие атомы переходных металлов в основной цепи
- В17. А.Г.Иванов, Н.М.Геллер, Л.Б.Надеждина, В.В.Шаманин**
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург
Электропроводящие кремний- и оловосодержащие полиазометины
- В18. В.Л.Берковиц, А.Г.Колосько, Е.И. Теруков, Ж.-П.Клейдер***
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург
** Laboratoire de Génie Électrique de Paris/Supélec (CNRS UMR8507), 11 Rue Joliot-Curie, Plateau de Moulon, 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, France*
Исследование пленок фталоцианина палладия методом спектроскопии анизотропного отражения
- В19. А.Ю.Осадчев, В.В.Шаманин, Ю.В.Рудь¹, Е.И.Теруков¹**
Институт высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург
¹*Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург*
Фотолюминесцентные свойства полигомосопряженных полимеров

СЕКЦИЯ С

АМОРФНЫЙ УГЛЕРОД И ДРУГИЕ ШИРОКОЗОННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

- С01. В.А. Титов^а, В.И.Рахлин^б, А.А.Титов^а, З.И.Семенова^а**
^а*Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН, г. Новосибирск*
^б*Иркутский институт химии СО РАН им. А.Е.Фаворского, г. Иркутск*
Термодинамическое моделирование поведения новых прекурсоров оксида и нитрида кремния в процессах получения диэлектрических слоев
- С02. С.Г.Ястребов, С.К.Гордеев*, М.Гаррига**, М.И.Алонсо**, В.И.Иванов-Омский**
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
**ФГУП Центральный научно-исследовательский институт материалов 191014 Санкт-Петербург, Россия*
***Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, CSIC 08193 Bellaterra (Spain)*
Эллипсометрия наноалмазного композита
- С03. С.Zuniga¹, А.Kosarev¹, А.Torres¹, J.A.Johnson², А. Erdemir², and О. L. Eryilmaz²**
¹*Institute National for Astrophysics, Optics and Electronics, Tonatzintla,*

Puebla, 72840, Mexico

² *Argonne national Laboratory, Argonne, Illinois 60439-4845, USA*

Conductivity measurements on “near-frictionless carbon films”

- C04.** **Н.Е. Яханова, А.Н. Чувывров, К.А. Лавренова**
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
Свойства графита с двумерной наноструктурой
- C05.** **О.В. Александров, Н.Н. Афонин***
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
**Воронежский государственный педагогический университет*
Влияние переходной ускоренной диффузии на перераспределение имплантированной сурьмы в системе a-SiO₂-c-Si
- C06.** **Р.У. Шаяхметов, Ю.М. Юмагузин**
Башкирский государственный университет
Полевая электронная спектроскопия углеродной плёнки на металле
- C07.** **А.В. Русавский, А.В. Васин, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, С.Н. Дуб¹, N. Andre², J.-P. Raskin²**
Институт физики полупроводников НАН Украины, Киев, Украина
¹*Институт сверхтвёрдых материалов НАН Украины, Киев, Украина*
²*CeRMiN, Universite catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium*
Структурные и механические свойства плёнок аморфного карбида кремния для MEMS-устройств.
- C08.** **А.А. Попов, А.Е. Бердников, В.Д. Черномордик**
Институт микроэлектроники и информатики РАН, Ярославль
Особенности материала «нанокластеры кремния в нитриде кремния», осажденного в низкочастотном разряде
- C09.** **В.В. Соболев, В.Вал. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Оптические свойства аморфного нитрида кремния
- C10.** **В.П. Афанасьев, А.П. Сазанов, А. М. Спивак**
Санкт – Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Контактные системы к тонким пленкам нитрида алюминия
- C11.** **А.Е. Кравчик, Ю.А. Кукушкина, В.В. Соколов, Г.Ф. Терещенко**
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбида бора методом термохимической обработки

СЕКЦИЯ D

ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ И СТЕКЛООБРАЗНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

- D01.** **В.В. Галян, Г.Е. Давыдюк, Н.В. Шевчук, А.Г. Кевшин, Ю. Когут**

Волынский государственный университет имени Леси Украинки
Рентгеноструктурный анализ стеклообразных сплавов системы $\text{GeS}_2\text{-AgGaS}_2\text{-AgGaSe}_2\text{-GeSe}_2$

- D02.** **Н.В. Болягин, С.П. Вихров, Т.Г. Ларина, С.М. Мурсалов**
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань, Россия
Диагностика структуры поверхностей неупорядоченных полупроводников
- D03.** **С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, А.А. Маслов, В.Г. Мишустин**
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань, Россия
Коэффициент собирания фотогенерированных носителей заряда в тонкопленочных структурах на основе неупорядоченных полупроводников
- D04.** **А.И. Исаев, С.И. Мехтиева, Р.И. Алекперов**
Институт физики НАН Азербайджана
Влияние примеси редкоземельных атомов самария (Sm) на оптические свойства халькогенидных стеклообразных полупроводников системы Se – As
- D05.** **С.П. Зимин¹, Е.С. Горлачев¹, М.Н. Герке², О.Ю. Приходько³, А.П. Рягузов**
¹ *Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова*
² *Владимирский государственный университет*
³ *Казахский национальный университет им. Аль-Фараби*
Исследование структурных характеристик аморфных пленок As_2Se_3 на мезопористом кремнии методами атомно-силовой микроскопии
- D06.** **Э.С.Хужакулов**
Ташкентский областной государственный педагогический институт
Атомы внедрения, возникающие при структурных перестроениях стекол
- D07.** **И.А. Барыгин^{1,2}, А.И. Капустин², К.Д. Цэндин¹**
¹ *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН*
² *Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Немонотонная температурная зависимость концентрации носителей в материалах с U-минус-центрами: халькогенидные стеклообразные полупроводники и высокотемпературные сверхпроводники.
- D08.** **Э. Ш. Алекперов, А.Ч. Мамедова, Э. М. Керимова, Д. И. Исмаилов**
Институт физики НАНА, Баку
Электроннографическое исследование кинетики кристаллизации нанотолщинных аморфных $\text{TIn}_{1-x}\text{Sn}_x\text{S}_2$.
- D09.** **Р.А. Кастро, А.В. Марченко, В.П. Волков, П.П. Серегин**
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
Изменение электронной плотности при переходах типа порядок-беспорядок в электронной подсистеме кристалла

- D10.** **Р.А.Кастро, А.А.Добродуб**
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
 U - центры олова в халькогенидных стеклообразных полупроводниках
- D11.** **Г.А.Бордовский, Р.А.Кастро**
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
 U - центры олова в стеклообразных сплавах халькогенидов свинца и германия
- D12.** **Е.В. Комаров, М.М. Сычев, Л.В. Григорьев*, С.В. Мякин**, И.В. Васильева**, В.П.Усачева*****
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
 * *Санкт-Петербургский государственный университет, Ст.Петергоф*
 * *Технологический центр РАДИАНТ, Санкт-Петербург*
 ** *Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург*
 Влияние содержания меди на изменение электролюминесцентных свойств цинксulfидного люминофора при облучении
- D13.** **В. Мица*, Р. Голомб**, М. Довгошей*, П. Йогансон**, А. Матик****
 * *Uzhgorod National University, 54 Voloshin str., Uzhgorod 88000, Ukraine*
 ** *Dep. Applied Physics, SMP, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden*
 КР спектры и полиморфные превращения в стеклах As-S при разных энергиях возбуждения
- D14.** **Р. Голомб*, М. Довгошей**, В. Мица**, П. Йогансон*, А. Матик***
 * *Dep. Applied Physics, SMP, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden*
 ** *Uzhgorod National University, Department of Solid State Physics, 54 Voloshin str., Uzhgorod 88000, Ukraine*
 Низкочастотные спектры комбинационного рассеивания технологически модифицированных стекол GeS₂, измеренных при разных энергиях возбуждения
- D15.** **В.Х. Кудоярова*, С.А. Козюхин**, К.Д. Цэндин*, В.М. Лебедев***, Е.А. Бабенко******
 * *Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург*
 ** *Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва*
 *** *Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина, Ленинградская обл.*
 **** *Московский энергетический институт (Технический Университет)*
 Исследование состава аморфных пленок As₂Se₃, модифицированных комплексным соединением Ln(thd)₃ (Ln= Er), по данным ядерного микроанализа и ИК-спектроскопии
- D16.** **В.Я. Когай, Е.В. Александрович, А.Ч. Хан, М.Н. Ладилова**
Институт прикладной механики УрО РАН, г. Ижевск
 Изучение особенностей роста тонких пленок Ga₂Te₃ и Se методом эллипсомерии

- D17.** Б.Т. Мелех, Л.А. Кулакова, В.Х. Кудоярова, С.А. Грудинкин, В.И. Бахарев
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Стеклообразование и физические свойства аморфных сплавов системы Ge-Te-Se
- D18.** В. В. Соболев, В. Вал. Соболев, А. В. Красноперов
Удмуртский Государственный Университет, Ижевск
Расчет комплексов оптических функций сплавов системы PbTe-SnTe
- D19.** Э. Ш. Гаджиев, А. И. Мададзаде, Д. И. Исмаилов, Э. М. Керимова, Э. Э. Алекперова
Институт физики НАНА, Баку, Азербайджан – 1143, пр.Г. Джавида 33,
Электроннографическое исследование кинетики фазовых превращений в аморфных пленках Yb As₄S₇
- D20.** Н.Н. Абдулзаде, Н.Н. Мурсакулов, Р.Г. Ахмедзаде
Институт физики национальной Академии наук Азербайджана
Кинетические характеристики Ag₂S
- D21.** Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, Т.Г. Мишина, С.А. Абушов
Институт физики национальной Академии наук Азербайджана, Баку.
Фотолюминесценция нанокристаллов Ga₂S₃:Eu
- D22.** Т.Г. Мамедов¹, Г.М. Шарифов¹, Ф.А. Микаилов^{1,2}, Е.Е. Шентюрк², Л. Тюмбек²
¹*Институт физики НАН Азербайджана AZ 1143, Баку, пр. Г.Джавида 33*
²*Институт высоких технологий Гебзе, Гебзе, 41400, Коджаели, Турция*
Влияние дефектов на поведение диэлектрической восприимчивости слоистого кристалла TlGaSe₂ с несоизмерной фазой
- D23.** А.А. Фарзалиев, И.И. Алиев, О.М. Алиев, И.Г. Алиев
Институт химических проблем НАН Азербайджана
Химическое взаимодействие и стеклообразование в системе As₂Se₃-Tl₃As₂S₃Se₃
- D24.** Н.Р. Ахмедова, О.М. Алиев
Институт химических проблем НАН Азербайджана, Баку
Стеклообразование в системах SmS-Ga₂S₃, EuS- Ga₂S₃ и YbS- Ga₂S₃
- D25.** Р.С. Магоммедрагимова, И.И. Алиев, В.М. Рагимова
Институт химических проблем Национальной АН Азербайджана
Фазовое равновесие и стеклообразование в системе As₂Se₃-In₃As₂S₃Se₃
- D26.** Э.М. Годжаев, А.А. Ахмедов
Азербайджанский Технический Университет
Пьезорезистивный эффект в монокристаллах TlIn_{1-x}Yb_xSe₂

- D27.** **В.В. Соболев, В.Вал. Соболев, В.А. Пагин**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
 Оптические свойства кристалла CuGaS₂
- D28.** **В. В. Учайкин, Р.Т.Сибатов**
Case Western Reserve University, Cleveland, USA
Ульяновский государственный университет
 Дробно-дифференциальная теория переноса заряда в аморфных полупроводниках
- D29.** **В.Ю. Колосов, Л.М. Веретенников, К.Л. Швамм**
УрГЭУ, г. Екатеринбург
 Кристаллизация тонких аморфных плёнок бинарной системы Sb-Te с выделением внутренне искривленных микрокристаллитов Te
- D30.** **Н.А. Богословский, К.Д. Цэндин.**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
 Интерпретация экспериментальных данных по оптической записи информации в халькогенидных стеклообразных полупроводниках
- D31.** **А.А. Бабаев, С.Б. Сулганов, А.М. Асхабов**
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала
 Электрические, оптические и магнитные свойства стеклообразного сегнетоэлектрика SbSi, легированного Mn, Fe, Ni

21 ИЮНЯ

СЕКЦИЯ Е

**МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
 ПОЛУПРОВОДНИКИ И СПЛАВЫ**

- 9:00** **В.А.Терехов⁵, М.Г.Иванов^{1,2}, М.Д.Ефремов¹, В.А.Володин¹, Д.В.Марин¹,
 А.И.Корчагин³, В.В.Черепков³, А.В.Лаврухин³, С.Н.Фадеев³,
 Р.А.Салимов³, С.П.Бардаханов⁴, В.М. Кашкаров⁵, К.Н. Панков⁵, Э.П.
 Домашевская⁵**
¹Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
²Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск
³Институт ядерной физики им. Г.Г.Будкера СО РАН, Новосибирск
⁴Институт теоретической и прикладной механики, Новосибирск
⁵Воронежский Государственный университет, Воронеж
 Структура и оптические свойства нанопорошков кремния
- 9:20** **Д.Н. Унучек^а, Н.В. Гапоненко^а, Е.А. Степанова^а, М.В Степихова^б,
 А. Козанецки^с, В. Глуханик^с**
^аБелорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
^бИнститут физики микроструктур РАН
^сInstitute of Physics, Polish Academy of Sciences

Фотолюминесценция эрбия в ксерогеле оксида железа, сформированного в пористом анодном оксиде алюминия

9:40 **С.П. Зимин¹, Е.С. Горлачев¹, Ю.М. Канагеева², А.Ю. Савенко², В.В. Лучинин², В.А. Мошников²**
¹ Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
² Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Структурные и электрические характеристики пористого кремния со сложной морфологией

10:00 **В.А. Юхимчук¹, М.Я. Валах¹, В.М. Джаган¹, О.С. Литвин¹, А.М. Яремко¹, З.Ф. Красильник², А.В. Новиков²**
¹ Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины, Киев
² Институт физики микроструктур РАН, Н.Новгород
Релаксация напряжений в GeSi nanoостровках, закрытых кремниевым слоем

10:20 **С.К. Лазарук, Д.А. Сасинович, П.С. Кацуба, А.Г. Смирнов, В.А. Лабунов**
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Формирование пористого анодного оксида алюминия с регулируемым наклоном пор

10:40 **В.Е. Оглуздин**
Научная организация «Центр лазерной технологии и материаловедения», Москва
Методика расчета коэффициента упругости, характеризующего в кремниевых наноструктурах связь оптического электрона с атомами среды

11:00- 11:20 кофе

11:20 **А.П. Авачев¹, Н.В. Вишняков¹, С.П. Вихров¹, В.Г. Мишустин¹, К.В. Митрофанов¹, И.Г. Уточкин¹, А.А. Попов²**
¹ Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань
² Институт микроэлектроники и информатики РАН, г. Ярославль
Измерение поверхностного и объемного зарядов в микро- и наноразмерных структурах на неупорядоченных полупроводниках

11:40 **Р.А. Алиев, В.А. Климов*, И.О. Попова, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин***
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
** Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН*
Оптические и электрические свойства поликристаллических слоев диоксида ванадия вблизи фазового перехода металл-полупроводник

12:00 **В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов**
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН
Создание низкоразмерных электронных структур в многослойных системах на основе кремния методом СТМ

12:40-13:40 обед

СЕКЦИЯ F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- 13:40** Э.Н. Воронков, С.А. Козюхин*, Е.А. Бабенко,
Московский энергетический институт, Москва
*Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва
Выпрямление в тонкопленочных структурах на основе халькогенидных
стеклообразных полупроводников
- 14:00** В.В. Путролайнен^{1,2}, А.Б. Черемисин^{1,2}, А.А. Величко¹, А.Л. Пергамент¹,
¹*Петрозаводский государственный университет*
²*Condensed Matter Physics, Department of Microelectronics and Information
Technology, Royal Institute of Technology, SE-164 40 Stockholm - Kista, Sweden*
Получение тонких пленок оксида ванадия методом лазерной абляции
- 14:20** А.А. Дукин, В.Г. Голубев
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Увеличение эффективности оптической накачки ионов эрбия в
 $a\text{-SiO}_x\text{:H}/a\text{-Si:H}$ микрорезонаторе
- 14:40** С.К. Лазарук, А.В. Долбик, В.А. Лабунов, В.Е. Борисенко
*Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники*
Использование процессов горения и взрыва наноструктурированного
пористого кремния в микросистемных устройствах
- 15:00** А.П. Авачев, С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, А.А. Маслов, В.Г. Мишустин
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань,
Особенности ВАХ контакта металл – некристаллический полупроводник
- 15:20** Б.А. Наджафов
Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
Солнечные батареи с барьером Шоттки
- 15:40** Л.Н. Зеленина, Т.П. Чусова, Ю.Г. Стенин, В.В. Баковец, Т.М. Левашова
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск
Фторорганические производные элементов II–VI групп: термодинамика
фазовых переходов и получение пленок на их основе

16:00-16:20 кофе

17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕКЦИЯ Е

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПОЛУПРОВОДНИКИ И СПЛАВЫ

- Е01. В.П. Афанасьев, Г.П. Крамар**
Санкт-петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Старение в тонкопленочных структурах на основе нанокристаллических пленок ЦТС
- Е02. Ф.Ф. Комаров¹, Н.И. Мухуров², А.В. Мудрый³, Л.А. Власукова¹,
А.В. Иванюкович³**
¹*Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь*
²*Институт электроники НАН Беларуси, Минск, Беларусь*
³*Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск*
Интенсивная голубая люминесценция аморфного нанопористого оксида алюминия
- Е03. Д.А. Курдюков¹, Н.Ф. Картенко¹, В.Г. Голубев¹, Т.В. Мурзина²,
О.А. Акципетров²**
¹*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург*
²*Московский государственный университет, физический факультет, Москва*
Синтез железо-иттриевого граната в порогах опала с использованием буферного слоя нитрида галлия
- Е04. Ю.В. Рябчиков, Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, И.А. Белогорохов,
В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров**
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра ОФимЭ
Генерация синглетного кислорода в порошках и водных суспензиях пористого кремния
- Е05. А.И. Попов*, Н.Д. Васильева*, Г.Ф. Воробьева, М.Д. Малинкович,
Ю.Н. Пархоменко, Н.А. Филипьев, М.Л. Шупегин**
Московский государственный институт стали и сплавов (МИСиС)
** Московский Энергетический институт (МЭИ)*
Анизотропия электропроводности нанокompозитов с кремний-углеродной матрицей, содержащих нанofазу на основе вольфрама
- Е06. В.И. Соколов, Л.М. Сорокин, А.Е. Калмыков, Л.В. Григорьев¹**
¹*ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург*
²*НИИ Физики им. В.А.Фока, СПб, Ст. Петергоф*
Транспортные свойства гетерогенной композиции – термически окисленного микропорошка кремния.
- Е07. А.Г. Панфилов, А.В. Родина, М.А. Абдуллаев, И.С. Панкратов,
М.Э. Сасин, Р.П. Сейсян**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

Институт физики ДНЦ РАН, г. Махачкала

Подавление сильным магнитным полем квантово-размерных эффектов возбужденных состояний экситона в тонких кристаллах CdSe

- E08.** **С.Ф. Каплан, В.Г. Голубев**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
Влияние температуры на формирование коллоидных частиц α -SiO₂ при щелочном гидролизе ТЭОС изготовление пленочных трехмерных фотонных кристаллов из сфер аморфного диоксида кремния
- E09.** **С.А. Аржанникова¹, В.А. Володин¹, М.Д. Ефремов¹, Г.Н.Камаев¹, Д.В. Марин¹, В.С. Шевчук¹, А.А.Попов², Ю.А.Минаков²**
¹*Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск*
²*Институт микроэлектроники и информатики РАН, Ярославль*
Наблюдение перезарядки кремниевых кластеров в нитриде кремния, полученном методом PCVD
- E10.** **Б.М. Костишко, А.В. Золотов**
Ульяновский Государственный Университет.
Моделирование динамики деградации пор в пористом кремнии под действием неоднородного температурного поля
- E11.** **В.А. Беляков, В.А. Бурдов**
Нижегородский государственный университет, 603950 Нижний Новгород
Примесные состояния в кремниевых квантовых точках
- E12.** **Н.В. Гапоненко^a, Г.К. Маляревич^a, Д.А. Циркунов^a, Д.Н. Унучек^a, М.В. Степихова^b, А.В. Мудрый^c**
^a*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники*
^b*Институт физики микроструктур РАН*
^c*Институт физики твердого тела и полупроводников, НАН Беларуси*
Синтез и физико-химические исследования структур ксерогель/пористый анодный оксид алюминия
- E13.** **А.И. Ряснянский^{1,2}, Р.А. Ганеев², Т. Усманов²**
¹*НПО "Академприбор", Академгородок, Ташкент, Узбекистан*
²*Самаркандский Государственный университет им. А. Навои, Самарканд, Узбекистан*
Оптические и нелинейно-оптические характеристики растворов полупроводниковых наночастиц приготовленных методом лазерной абляции
- E14.** **С.П. Тимошенков, О.М. Бритков, В.И. Графутин^{*}, С.А. Зотов, В.В. Калугин, Ю.Я. Лапицкий^{*}, Е.П. Светлов-Прокопьев^{*}, Ан.С. Тимошенков**
Московский институт электронной техники (технический университет)
^{}Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И.Алиханова*
Рост и легирование эпитаксиальных слоев кремния, осаждаемых в гидридном и хлоридных процессах, при скоростном нагреве подложек некогерентным излучением в производстве структур КНИ

- E15.** **В.В. Соболев, В.Вал. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Фундаментальные спектры нанобразцов дисилицида железа
- E16.** **Л.П. Казакова, М.Г. Мынбаева, К.Д. Мынбаев**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Перенос носителей заряда в пористом карбиде кремния
- E17.** **О.В. Гончарова¹, В.Ф. Гременок², В.М. Кравченко³, А.В. Кравченко³, О.В. Ермаков³, В.Б. Залесский³**
¹ *Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси*
² *Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси*
³ *Институт электроники НАН Беларуси*
Структурные и оптические свойства прозрачных нано-кристаллических пленок In_2S_3
- E18.** **С.Г. Черкова, Д.В. Марин, Г.А. Качурин, М. Deutschmann¹**
Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск,
¹ *Laser Zentrum Hannover, 30419 Hannover, Germany.*
Формирование и отжиг дефектов структуры в люминесцирующих нанокристаллах Si
- E19.** **М.Н. Мартышов, Л.В. Шапошников, П.А. Форш.**
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Электропроводность пористого кремния при различных конфигурациях электрических контактов
- E20.** **Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Тербуков**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Фотопреобразование в структурах на основе фосфида бора
- E21.** **И.С. Савинов, Э.Н. Воронков**
Московский энергетический институт, Москва
Расчет динамики процесса кристаллизации в ячейках энергонезависимой памяти с фазопеременной средой
- E22.** **И.Б.Копелев**
Московский энергетический институт, Москва,
Моделирование фазового перехода кристалл- аморфное состояние

СЕКЦИЯ F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

- F01.** **С.М. Малышкин, В.М. Корнилов***
Башкирский государственный университет
**Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН*
Исследование свойств автоэмиссионных катодов с полимерным покрытием

- F02.** **И.А. Викторов¹, В.Ф. Гременок¹, Е.П. Зарецкая¹, В.А. Иванов¹, Т.Р. Леонова²**
¹ГНУ «Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников» НАНБ, Минск
²ГНУ «Институт электроники» НАНБ, Минск
 Исследование электро-оптических свойств пленок ZnO:Al, полученных магнетронным напылением
- F03.** **Э.М. Годжаев, Э.А. Аллахъяров, Э.М. Мамедов, Х.С. Халилова**
 Азербайджанский технический университет, Азербайджан, Баку
 Акустофотовольтаический эффект в цепочечных кристаллах типа $A^{III}B^{III}C^{VI}_2$
- F04.** **А.И. Андреев, С.М. Кокин**
 Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
 Повышение яркости и увеличение напряжения пробоя порошковых электролюминесцентных слоёв введением в них мелкодисперсного диэлектрика
- F05.** **М.Т. Дадашев¹, Т.М. Панахов², М.М. Дадашова¹**
¹Азербайджанский технический университет, Баку
²Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Баку
 Технология изготовления и некоторые особенности пьезоэлементов на основе тройных соединений типа TlSe
- F06.** **Н.С. Грушко, Л.Н. Потанахина, С.А. Амброзевич**
 Ульяновский государственный университет
 Спектры и эффективность электролюминесценции структуры на основе InGaN
- F07.** **В.В. Малютина-Бронская, В.Б. Залесский, Т.Р. Леонова**
 Институт электроники НАН Беларуси, г. Минск
 Емкостные характеристики структур оксикарибид кремния - кремний
- F08.** **С.Н. Каллаев, Г.Г. Гаджиев, З.М. Омаров, А.А. Бабаев А.Р. Билалов**
 Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала
 Особенности теплофизических свойств полупроводниковой сегнетопьезокерамики ПКР-7М
- F09.** **С.К. Лазарук, Д.А. Сасинович, П.С. Кацуба, В.А. Лабунов, А.А. Лешок, В.Е. Борисенко**
 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
 Электролюминесценция в пористом кремнии, встроенном в матрицу анодного оксида алюминия
- F10.** **Т.Л. Кулова, А.М. Скундин, Ю.В.Плесков, Е.И. Теруков*, О.И.Коньков*, И.Н.Трапезникова***
 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН
 Москва
 *Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Исследование внедрения лития в аморфный кремний методом спектроскопии электрохимического импеданса

- F11.** **Ю. Ф. Бирюлин, Д. С. Курдыбайло¹, Т. Л. Макарова, В. Л. Негров², А. В. Приходько¹, И. И. Сайдашев, Е. И. Теруков, А. Г. Ткачев², Г. П. Алексюк³, В. В. Шаманин³**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург
¹*Санкт-петербургский государственный политехнический университет*
²*Тамбовский государственный технический университет*
³*Институт высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург*
Проводящие композиционные покрытия на основе нанолуглеродных волокон в латексной бутадиен-стирольной матрице
- F12.** **С. С. Османова, Э. А. Аллахъяров, Т. П. Мусаев, И. Г. Гамдуллаева**
Азербайджанский технический университет, Азербайджан, Баку
Новые электретные материалы типа ПЭНП + X ВЕС. % TlInSe₂ (Ga, In, Tl)
- F13.** **А. Б. Черемисин^{1,2}, В. В. Путролайнен^{1,2}, А. А. Величко¹, А. Л. Пергамент¹, Г. Б. Стефанович¹, А. М. Grishin²**
¹*Петрозаводский государственный университет*
²*Condensed Matter Physics, Department of Microelectronics and Information Technology, Royal Institute of Technology, SE-164 40 Stockholm-Kista, Sweden*
Модификация физико-химических свойств тонких аморфных пленок оксидов ванадия под действием излучения эксимерного лазера.
- F14.** **А. Ш. Абдинов, Г. М. Мамедов, С. И. Амирова**
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
Фоточувствительные гетеропереходы SnO₂/Cd_{0.4}Zn_{0.6}S_{0.8}Se_{0.2}/CdTe, полученные методом электрохимического осаждения
- Н. Т. Гурин, О. Ю. Сабитов**
- F15.** *Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия*
Процессы ударного возбуждения в пленочных электролюминесцентных структурах на основе ZnS:Mn
- F16.** **П. В. Гаенко, А. Г. Забродский, В. Г. Малышкин, Ю. А. Николаев, Е. И. Теруков, И. Н. Трапезникова**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
Влияние частоты ультразвукового диспергирования платинированной сажи при приготовлении каталических «чернил» на удельную мощность в твердополимерном топливном элементе
- F17.** **Ю. А. Николаев, В. Ю. Рудь*, Ю. В. Рудь, Е. И. Теруков, Т. Н. Ушакова**
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
**Санкт-Петербургский государственный политехнический университет*
Гетерофотоэлектроника мелкодисперсных сред

СЕКЦИЯ G

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- G01.** **О.Я. Березина, А.А. Величко, А.Л. Пергамент, Г.Б. Стефанович, С.А Мануйлов, Е.С. Коцуба, И.А. Мельниченко**
Петрозаводский государственный университет
Зависимость физических свойств пленок оксидов ванадия, легированных вольфрамом, от концентрации примеси
- G02.** **А.И. Калугин, В.Н. Костенков, В.В. Соболев, В.Вал. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Спектр характеристических потерь электронов и оптические свойства TiCl
- G03.** **А.И. Калугин, И.В. Востриков, В.В. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Фундаментальные оптические спектры диоксида свинца
- G04.** **А.И. Калугин, Е.В. Баранова, В.В. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Оптические спектры хлорида кадмия
- G05.** **С.Г. Исхакова, А.И. Калугин, В.В. Соболев**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Оптические свойства и электронная структура нитрита натрия
- G06.** **В.В. Соболев, В.Вал. Соболев, Д.С. Деревяга**
Удмуртский государственный университет, Россия, Ижевск
Фундаментальные оптические свойства ортосиликата висмута
- G07.** **В. В. Соболев, В.Вал. Соболев, Д. М. Ураков**
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Спектр комплекса оптических функций титаната стронция
- G08.** **Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, С.А. Абушов, Ф.А. Казымова**
Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку
Антистоксова люминесценция кристалла $\text{YbGa}_2\text{S}_4:\text{Er}$.
- G09.** **С. Бартоу², П. Беналоул², О.Б. Тагиев¹, В.А. Кузнецова⁴, К.О. Тагиев³**
¹*Институт физики НАН Азербайджана, Баку*
²*Франция, Париж F-75252, Университет им.П.и М.Кюри, CNRS-UMR 7601*
³*Бакинский государственный университет*
⁴*Институт химии силикатов РАН, Россия, Санкт-Петербург*
Люминесценция кристаллов BaSiO , активированных ионами Er^3
- G10.** **Д.В. Бугурович, М.В. Кузьмин, М.В. Логинов, М.А. Митцев**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Осцилляции фриделя в неупорядоченных, метастабильных пленках иттербия, создаваемых на поверхности кремния $\text{Si}(111)7\times 7$

- G11.** **В.А. Логачева, А.Н. Лукин, А.М. Ховив**
Воронежский государственный университет
Синтез и оптические свойства пленок WO₃, полученных отжигом вольфрама, осажденного магнетронным способом
- G12.** **Д.А. Кудряшов, С.Н. Грушевская, А.В. Введенский**
Воронежский государственный университет
Фотоэлектрические свойства анодно сформированного на серебре оксида Ag₂O
- G13.** **Д. С. Яковлева**
Петрозаводский государственный университет
Изменение электрических и оптических свойств тонких пленок гидратированного пентаоксида ванадия в результате электрохромного эффекта.
- G14.** **М.М. Мездрогина, В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова ***, С.Н.Родин
Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Пространственная неоднородность распределения редкоземельных ионов и кинетика неравновесных носителей заряда в вюрцитных кристаллах GaN, легированных Eu, Sm, Er, Tm
- G15.** **Ш.О. Эминов, А.А. Раджабли, Т.И. Ибрагимов**
Институт физики НАН Азербайджана, Баку
Growth features and surface morphology of InSb liquid phase epitaxial layers
- G16.** **Т.М. Гаджиев¹, Дж.Х. Магомедова¹, Р.М. Гаджиева¹, П.П. Хохлачев¹, Ш.А. Нурмагомедов²**
1. Институт физики Дагестанский научный центр РАН, Махачкала
2. Дагестанский государственный университет, Махачкала
Фото-и катодолуминесценция в кристаллическом CuInSe₂.
- G17.** **Ш.Б. Утамурадова, Х.С. Далиев, О.А. Бозорова, Ш.Х. Далиев**
Научно-исследовательский институт прикладной физики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
О нейтрализации железа в кремнии атомами гафния
- G18.** **Ш.Б. Утамурадова, Х.С. Далиев, Э.К. Каландаров, Ш.Х. Далиев**
Научно-исследовательский институт прикладной физики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Трансформация энергетического спектра дефектов в Si<La> при термических обработках
- G19.** **Н.А. Авлеев, Г.С. Сиговцев**
Петрозаводский госуниверситет
Численное моделирование кинетики переходных фотогоков в диэлектрических слоях

- G20. И.Р. Набиуллин, В.М. Корнилов**
**Башкирский государственный университет, Уфа*
Институт физики молекул и кристаллов Уфимский научный центр РАН
Модификация системы Si/SiO₂ при исследовании методом сканирующей туннельной микроскопии
- G21. Т.П. Чусова, Л.Н. Зеленина, Ю.Г. Стенин, З.И. Семенова, А.А. Титов**
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск
Стандартные энтальпии образования и абсолютные энтропии жидкого и газообразного трихлорида галлия
- G22. П.А. Тихонов¹, М.В. Калинина¹, А.П. Пивоварова², Е.В. Орлова¹**
¹*Институт химии силикатов им. И.В. Гребенищикова РАН,*
²*Санкт – Петербургский государственный технологический институт (технический университет)*
Электрофизические и сенсорные свойства тонких оксидных пленок на основе ниобатов стронция
- G23. И.В. Боднар¹, И.Т. Боднар², И.В. Викторов², В.Ф. Гременок², М.Leon³.**
¹*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск*
²*Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск*
³*Universidad Autonoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain*
Получение и свойства пленок тройного соединения CuIn₅Se₈
- G24. И.В. Боднар¹, И.В. Викторов², В.Ф. Гременок², В.А. Полубок¹.**
¹*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск*
²*Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск*
Влияние отжига на структуру и оптические свойства пленок In₂S₃